

2SJ43

シリコン P チャネル接合形 / Si P-Channel Junction

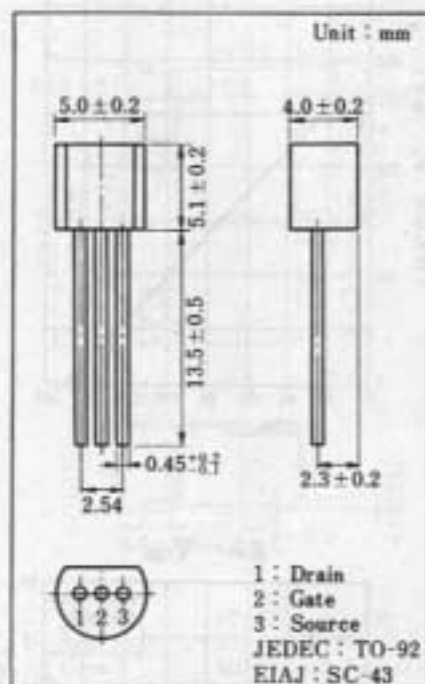
低周波増幅用 / AF Amplifier

■ 特徴 / Feature

- ゲート・ドレイン電圧 V_{GS} が高い。 / High V_{GS}

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
ゲート・ドレイン電圧	V_{GS}	50	V
ドレイン電流	I_D	20	mA
許容損失	P_D	250	mW
チャネル部温度	T_{ch}	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

■ 電気的特性 / Electrical Characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
ドレイン電流	I_{DSS}^*	$V_{DS} = -10\text{ V}, V_{GS} = 0$	-0.5		-12	mA
ゲートシャ断電流	I_{GSS}	$V_{GS} = 30\text{ V}, V_{DS} = 0$			0.1	μA
ゲート・ドレイン電圧	V_{GDS}	$I_G = 100\ \mu\text{A}, V_{DS} = 0$	50			V
ゲート・ソースシャ断電圧	V_{GSC}	$V_{DS} = -10\text{ V}, I_D = -10\ \mu\text{A}$	0.2		3	V
相互コンダクタンス	g_m	$V_{DS} = -10\text{ V}, V_{GS} = 0, f = 1\text{ kHz}$	3			mS
入力容量	C_{iss}	$V_{DS} = -10\text{ V}, V_{GS} = 0, f = 1\text{ MHz}$		22		pF
増速容量	C_{rss}			3.6		pF
雑音電圧	NV	$V_{DS} = -10\text{ V}, I_D = -1\text{ mA}, G_V = 80\text{ dB}$ $R_g = 100\text{ k}\Omega, \text{Function} = \text{FLAT}$			80	mV

* I_{DSS} ランク分類 / I_{DSS} Classifications

Class	P	Q	R
I_{DSS} (mA)	-0.5 ~ -3	-2 ~ -6	-4 ~ -12